

バンプの広域断面観察

イオンポリッシュによる断面作製で微小特定箇所の広域観察が可能です

測定法 : SEM・EDX・EBSD・IP法

製品分野 : 電子部品

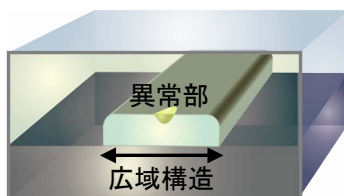
分析目的 : 組成評価・同定・形状評価・組成分布評価・構造評価・製品調査

概要

イオンポリッシュ(IP)法では、機械研磨法で問題となっていた加工ダメージ(界面の剥離・硬さの違いによる段差・研磨による傷など)が少ない断面の作製が可能です。加工位置精度も向上し、微小部位を含む広域断面作製も可能です。結晶の損傷が少ないため、綺麗な結晶パターンが得られます。また、機械的応力の影響がないため、内部構造を忠実に保存したまま、AES分析・SEM観察・EDX分析などにより、詳細に特定部位の断面構造を評価できます。

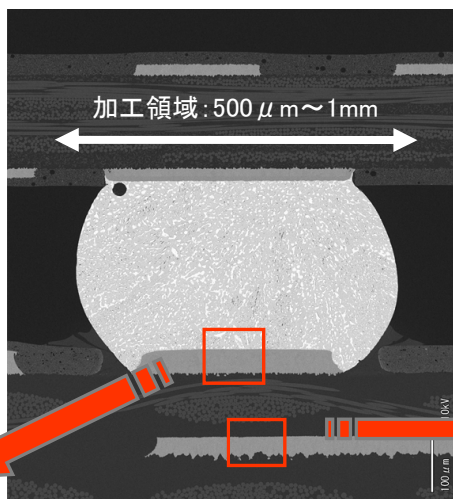
データ

■微小部位を含む広域断面加工

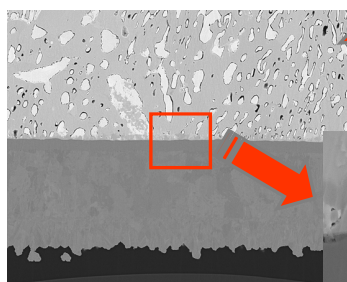


「微小部位(異常部など)」と「広域構造」の断面観察・分析が同一断面で可能です。

■ダメージレスな広域断面

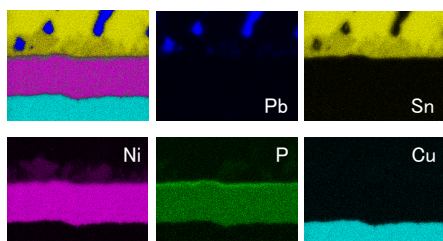


■結晶粒観察



SEM像(反射電子像)

■組成分析

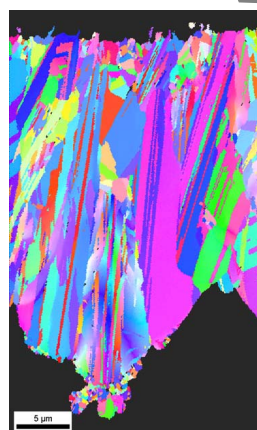
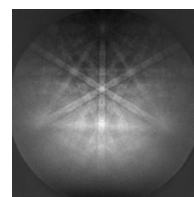


EDXマッピング像

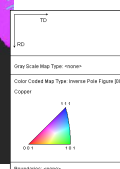
■結晶性評価



菊池パターン



逆極点図方位マップ



分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MIST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp

URL : <http://www.mst.or.jp/>